



Title of Change:	Qualification of ON Bucheon, Korea facility as an additional wafer fab location for C-FET Technology
Proposed First Ship date:	04 Nov 2021 or earlier if approved by customer
Contact Information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or Gapyeol.Kim@onsemi.com
PCN Samples Contact:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com> . Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change. Samples delivery timing will be subject to request date, sample quantity and special customer packing/label requirements.
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or songyong.sim@onsemi.com
Type of Notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact PCN.Support@onsemi.com
Marking of Parts/ Traceability of Change:	Affected parts will be identified with a date code of ww42'21 or later
Change Category:	Wafer Fab Change
Change Sub-Category(s):	Manufacturing Site Addition

Sites Affected:	
ON Semiconductor Sites	External Foundry/Subcon Sites
ON Semiconductor Bucheon, Korea	Towerjazz Semiconductor, Japan (Toyama)

Description and Purpose:		
	Before Change Description	After Change Description
FAB Site	Towerjazz Semiconductor, Japan(Toyama)	Towerjazz Semiconductor, Japan(Toyama) ON Semiconductor Bucheon, Korea

Reliability Data Summary:

QV DEVICE NAME: FQPF10N60C (QV1)
RMS: K75484
PACKAGE: TO220F

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Tj=150°C, 80% max rated V	1008 hrs	0/240
HTGB	JESD22-A108	Tj=150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs	0/240
HTSL	JESD22-A103	Ta=150°C	1008 hrs	0/240
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 3.5 min	8572 cyc	0/120
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to + 150°C	1000 cyc	0/120
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs	0/120
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/120

**Electrical Characteristics Summary:**

The temperature characterization and ESD performance meet datasheet specification. Detail of Electrical characterization result is available upon request.

List of Affected Parts:

Note: Only the standard (off the shelf) part numbers are listed in the parts list. Any custom parts affected by this PCN are shown in the customer specific PCN addendum in the PCN email notification, or on the [PCN Customized Portal](#).

Part Number	Qualification Vehicle
FQPF10N60C	FQPF10N60C
FQU5N60CTU	FQPF10N60C
FQP3N50C-F080	FQPF10N60C
FQU3N50CTU	FQPF10N60C
FQN1N60CTA	FQPF10N60C
FQN1N50CTA	FQPF10N60C
FQU3N60CTU	FQPF10N60C
FQP3N60C	FQPF10N60C
FQD3N60CTM-WS	FQPF10N60C
FQU5N50CTU-WS	FQPF10N60C
FQPF5N50CYDTU	FQPF10N60C
FQD5N50CTM-WS	FQPF10N60C
FQB5N50CTM	FQPF10N60C
FQD6N50CTM	FQPF10N60C
FQT1N60CTF-WS	FQPF10N60C
FQN1N60CTA-G	FQPF10N60C

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号# : FPCN23448X

発行日: 28 Jul 2021

変更件名:	C-FET 技術向けのウエハ製造拠点としてオン富川 (韓国) の施設の追加認証	
初回出荷予定日:	2021 年 11 月 04 日またはお客様からの承認が得られた場合はそれ以前.	
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < Gapyeol.Kim@onsemi.com > にお問い合わせください。	
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または < PCN.Samples@onsemi.com > にお問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回 PCN または最終 PCN の最初の通知の日付から 30 日以内に要求してください。 サンプル納入時は、依頼日、数量、特別梱包材/ラベル条件によって異なります。	
追加の信頼性データ:	お客さまの地域のオン・セミコンダクター営業所または < songyong.sim@onsemi.com > にお問い合わせください。	
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、< PCN.Support@onsemi.com > 宛てにお願いします。	
変更部品の識別:	影響を受ける部品は ww42'21 以降のデータコードで識別します。	
変更カテゴリ:	ウエハファブの変更	
変更サブカテゴリ:	製造拠点の追加	
影響を受ける拠点:		
オン・セミコンダクター拠点:	外部製造工場 / 下請業者拠点:	
ON Semiconductor Bucheon, Korea	Towerjazz Semiconductor, Japan (Toyama)	
説明および目的:		
	変更前の表記	変更後の表記
製造拠点	Towerjazz Semiconductor, Japan(Toyama)	Towerjazz Semiconductor, Japan(Toyama) ON Semiconductor Bucheon, Korea

信頼性データの要約:

デバイス名: FQPF10N60C (QV1)

RMS: K75484

パッケージ: TO220F

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Tj=150°C, 80% max rated V	1008 hrs	0/240
HTGB	JESD22-A108	Tj=150°C, 100% max rated Vgss	1008 hrs	0/240
HTSL	JESD22-A103	Ta=150°C	1008 hrs	0/240
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 3.5 min	8572 cyc	0/120
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to + 150°C	1000 cyc	0/120
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	96 hrs	0/120
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/120

**電気的特性の要約:**

温度特性および ESD 性能はデータシートの仕様に適合します。電気的特性結果の詳細は、要求に応じて入手可能です。

影響を受ける部品の一覧:

注: 部品一覧には標準部品番号 (既製品) のみが記載されています。本 PCN の影響を受けるカスタム部品番号は、PCN メールで提供される顧客個別の付録、または PCN カスタマイズポータルに記載されています。

部品番号	認定試験用ピークル
FQPF10N60C	FQPF10N60C
FQU5N60CTU	FQPF10N60C
FQP3N50C-F080	FQPF10N60C
FQU3N50CTU	FQPF10N60C
FQN1N60CTA	FQPF10N60C
FQN1N50CTA	FQPF10N60C
FQU3N60CTU	FQPF10N60C
FQP3N60C	FQPF10N60C
FQD3N60CTM-WS	FQPF10N60C
FQU5N50CTU-WS	FQPF10N60C
FQPF5N50CYDTU	FQPF10N60C
FQD5N50CTM-WS	FQPF10N60C
FQB5N50CTM	FQPF10N60C
FQD6N50CTM	FQPF10N60C
FQT1N60CTF-WS	FQPF10N60C
FQN1N60CTA-G	FQPF10N60C